
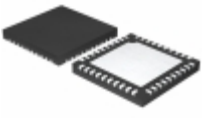







	<p><b>SI4778DY-T1-E3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4778DY-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 8A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4778DY-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 103208 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 8A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	103208 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SI4778DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4778DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4778DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4778DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4777-A20-GM</b> Silicon Labs IC RCVR AM/FM CE HD-RADIO TUNER</p>	 <p><b>SI4778DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4778DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4776DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 11.9A 8SO</p>
 <p><b>SI4779CY-T1-E3</b> VISHAY SI4779CY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4788</b> Original SI4788 Original</p>	 <p><b>SI4778DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4778DY</b> VISHAY SI4778DY VISHAY</p>

### SI4778DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<a href="#">Schlüsselwort</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>
<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>
<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>
<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>	<a href="#">SI4778DY-T1-E3</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited